



D882M

NPN

主要用途:

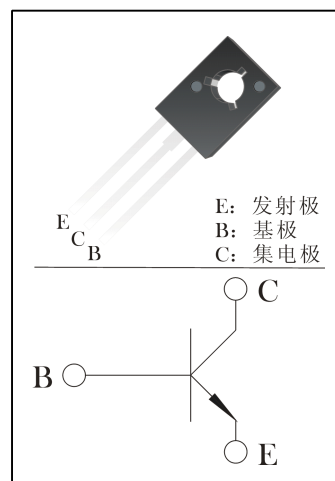
高频放大电路、应急灯、电动玩具控制电路。

主要特点:

硅外延平面工艺、输出特性好、电流容量大。

封装形式:

T0-126



极限值 (TC=25℃)

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-发射极击穿电压	BVce0	≥ 40	V
集电极-基极击穿电压	BVcb0	≥ 30	V
发射极-基极击穿电压	BVeb0	≥ 6	V
最大集电极直流电流	Icm	3	A
最大耗散功率	Pcm	35	W
最高工作温度	Tj	150	℃
贮存温度	Tstg	-55~150	℃

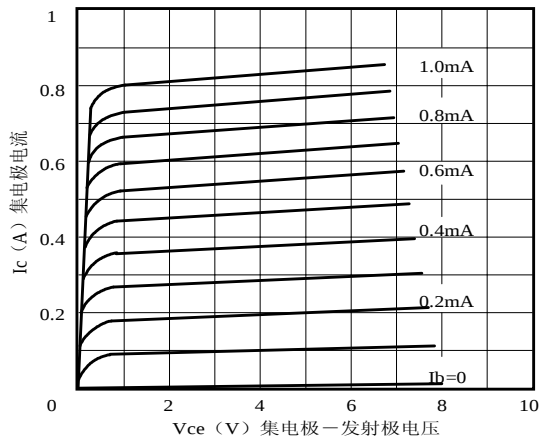
电特性 (TC=25℃)

参数名称	符号	测试条件	额定值		单位
			最小值	最大值	
集电极-发射极击穿电压	BVce0	Ic=1mA IB=0	30		V
集电极-基极击穿电压	BVcb0	Ic=1mA IE=0	40		V
发射极-基极击穿电压	BVeb0	IE=1mA IC=0	6		V
集电极-发射极反向漏电流	Ice0	Vce=30V IB=0		20	uA
集电极-发射极反向漏电流	Icb0	Vcb=40V IE=0		10	uA
发射极-基极反向漏电流	Ieb0	Veb=7V IC=0		10	uA
共发射极直流电流增益	Hfe	Vce=2V IC=1A	100	400	
集电极-发射极饱和压降	Vcesat	Ic=2A Ib=0.2A		0.6	
特征频率	fT	Vce=5V IC=0.1A f=10MHz	50		MHZ

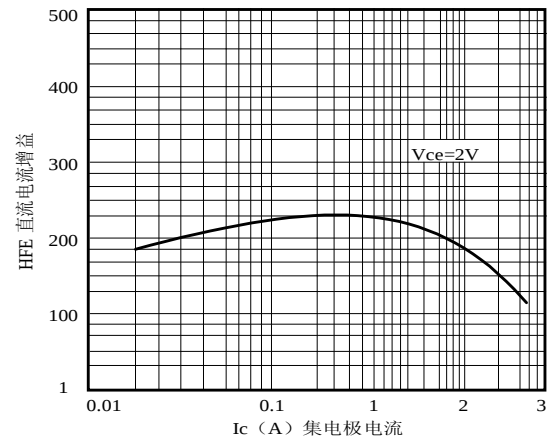


特性曲线

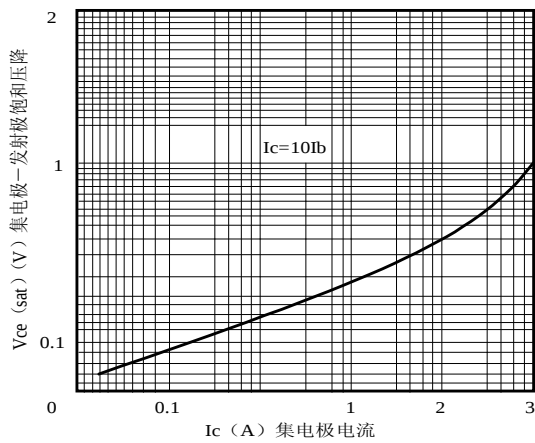
静态输出特性



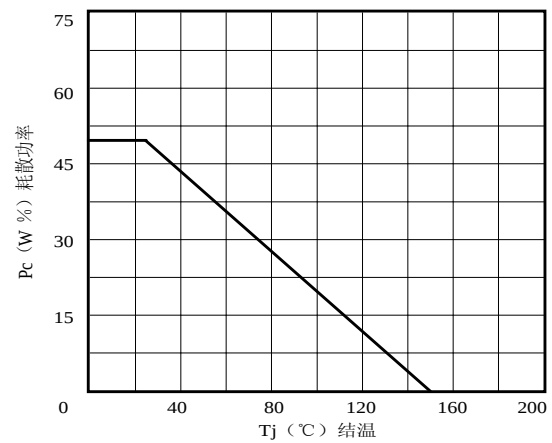
HFE 直流电流增益 - I_c 集电极电流



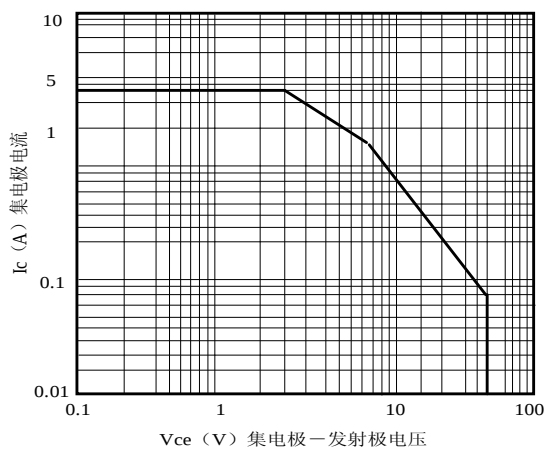
$V_{ce(sat)}$ 集电极 - 发射极饱和压降 - I_c 集电极电流



P_c 耗散功率 - T_j 结温



SOA (DC) 安全工作区





产品尺寸

TO-126

